4. Картвелишвили, К. З. Оптический циркулятор и его возможности для измерительной техники / К. З. Картвелишвили, А. Г. Данелия, Д. И. Гарибашвили // Измерительная техника. −1997. – №8. – С. 43–47.

УДК 681.327.68

Оптическое запоминающее устройство циркуляционного типа

Есман А. К., Зыков Г. Л., Потачиц В. А. Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь

В работе рассматривается техническое решение построения оперативной памяти на волоконно-оптическом контуре циркуляции. Приведены функциональная схема и принцип работы разработанного устройства. Предложенное техническое решение позволяет в 2 раза повысить максимальную частоту следования импульсов в контуре циркуляции при одинаковой полосе пропускания фотоприемников, увеличить максимальную информационную емкость памяти при той же длине контура.

Терабитные скорости передачи информации, небольшие потери и широкая полоса пропускания одномодовых волоконных световодов позволяют использовать замкнутые линии задержки с циркуляцией сигнала в качестве аналога динамического запоминающего устройства для высокоэффективного оперативного хранения и обработки информации [1–5].

В данной работе предлагается техническое решение построения оперативной памяти на волоконно-оптическом контуре циркуляции, позволяющий повысить тактовую частоту, а следовательно, увеличить информационную емкость памяти (рис. 1).



Рис. 1. Функциональная схема устройства

Информационный сигнал представляет собой кодовую цифровую последовательность импульсов в формате без возвращения к нулю. Этот сигнал поступает на шину 3 входных данных, а управляющий сигнал поступает на шину 5 управления записью. В тот же момент с шины 6 управления циркуляцией на второй управляющий вход коммутатора 7 поступает сигнал, блокирующий пропускание сигнала со второго информационного входа, подключенного к выходной шине 4, на выход коммутатора 7, с выходов которого информационный сигнал направляется на электрический вход первого модулятора 11, а также на первый 14 и второй 15 блоки задержки. Две серии импульсов, вырабатываемых управляемым генератором 8 импульсов, смещены относительно друг друга на величину, равную половине интервала следования. Сигнал синхронизации, который поступает с блока 2 синхронизации на вход управляемого генератора 8, задает величину смещения импульсов. Эти импульсы запускают генерацию импульсов оптического излучения с излучателей 9 и 10. Фазовый сдвиг $\Delta \varphi$, вносимый модуляторами 11, 12 и 13, между компонентами пропускаемого оптического излучения, имеющими взаимно ортогональную поляризацию, пропорционален уровню сигнала на электрическом входе.

Если величина информационного сигнала на входе модуляторов 11, 12 и 13 и величина полуволнового напряжения этих модуляторов будут равны, то символу «1» будет соответствовать фазовый сдвиг $\Delta \phi = \pi$, вносимый каждым из этих модуляторов, а символу «0» — фазовый сдвиг $\Delta \phi = 0$.

Если на входе первого излучателя 9 появится символ «1», то первый модулятор 11 внесет фазовый сдвиг $\Delta \varphi = \pi$. Импульсы второго излучателя 10 последовательно пройдут через второй 12 и третий 13 модуляторы, каждый из которых внесет фазовый сдвиг $\Delta \varphi = 0$ (если на электрическом входе будет символ «0») или $\Delta \varphi = \pi$ (если на электрическом входе будет символ «1»). Фазовый сдвиг $\Delta \varphi$ в оптическом луче на выходе третьего модулятора 13 равен сумме фазовых сдвигов, вносимых вторым 12 и третьим 13 модуляторами, которые управляются последовательностью импульсов с задержкой на 2 и 4 символа, соответственно, элементами задержки 14 и 15. Если управляющее и полуволновое напряжение будут равны, то фазовый сдвиг на выходе третьего 13 модулятора будет равен π ($a_{i-2} \oplus a_{i-4}$), где a_{i-2} и a_{i-4} — это символы последовательности с задержкой, соответственно, на 2 и 4 символа, каждый из которых может принимать значение «1» или «0».

Смеситель 16 объединяет выходные лучи модуляторов 11 и 13. Полученный оптический сигнал поступает в контур 1 циркуляции. Одновременно с шины 5 управления записью, подключенной к первому управляющему входу коммутатора 7, снимается разрешающий сигнал, а с шины 6 управления циркуляцией на второй управляющий вход коммутатора 7 подается разрешающий сигнал. При этом происходит соединение второго

информационного входа коммутатора 7 и его выхода, и, как следствие, замыкание контура циркуляции I информационного сигнала.

Модулятор 21, управляемый гармоническим сигналом с блока 2 синхронизации, осуществляет поляризационную модуляцию (т.е. модуляцию в оптическом диапазоне частот, основанную на изменении угла плоскости поляризации оптического излучения) оптического сигнала, поступающего с выхода контура 1 циркуляции (волоконного световода). Амплитуда управляющего напряжения на электрическом входе модулятора 21 по величине равна полуволновому напряжению. Таким образом, изменение поляризации каждого импульса оптического излучения происходит на $\pi/2$ относительно поляризации предшествующего импульса. Электрический канал модулятора 21, представляющий собой резонансную систему с узкой полосой частот, работает на постоянной частоте. На выходе модулятора 21 широкополосный оптический сигнал пространственно разделяется в соответствии с поляризационным признаком. Поэтому, на выходах поляризационного светоделителя 20 происходит выделение двух последовательностей импульсов, частота которых в два раза меньше частоты следования сигнала в контуре 1 циркуляции. С помощью фотоприемников 18 и 19 происходит детектирование этих последовательностей, которые после детектирования поступают на входы блока 17 коррекции, в котором происходит при необходимости коррекция пораженных символов. С выхода блока 17 коррекции информационный сигнал поступает на второй информационный вход коммутатора 7, который связан с шиной 6 управления циркуляцией, а затем вновь направляется на модуляторы 11, 12 и 13, замыкая процесс циркуляции. Вывод информации осуществляется через выходную шину 4 с выхода блока 17 коррекции информации.

При выполнении программ все их данные хранятся в оперативной памяти. Основными физическими факторами, определяющими два важных параметра оперативной памяти, являются объем V информации в битах и время ее хранения $t_{\rm xp}$ [6].

Объем памяти V определяется длиной L контура циркуляции, шириной полосы пропускания волоконного световода и количеством самих контуров. Если дисперсия стекловолокна допускает передачу информации со скоростью тактовой частоты f_t [7], то для одноконтурного запоминающего устройства количество информационных импульсов, которые могут распространяться по световоду в контуре циркуляции, и составляет объем памяти

$$V = \frac{Ln_{\rm rp}f_{\rm T}}{c},\tag{1}$$

где L — длина контура циркуляции; $n_{\rm rp}$ — показатель замедления групповой скорости (показатель преломления сердцевины одномодового волокна, в световодах на основе кварцевого стекла $n_{\rm rp}\approx 1,5$); c — скорость света в вакууме.

Время хранения информации определяется длиной контура циркуляции и вероятностью ошибки P_1 , которую допускает ретранслятор при однократной регенерации проходящей через него информации. После завершения K циклов регенерации, в получаемой информации может накопиться ошибка:

$$P_K = K P_1. (2)$$

Чаще всего, как показывает опыт работы с оперативной памятью, для большинства практических приложений хранящаяся в памяти системы информация будет пригодной для дальнейшего возможного использования, если дополнительная ошибка не превысит установленной величины порядка 10⁻⁹. Тогда время хранения информации в оперативной памяти будет определяться выражением:

$$t_{\rm xp} = \frac{Ln_{\rm rp}K}{c},\tag{3}$$

а качество ретрансляции будет обеспечивать ошибку P_1 , определяемую выражением (2) при $P_K = 10^{-9}$.

Выражения (1-3) определяют возможности и требования к основным параметрам волоконно-оптической оперативной памяти циркуляционного типа.

Таким образом, рассмотренное оптическое запоминающее устройство циркуляционного типа позволяет двукратно увеличить максимальную частоту следования импульсов в контуре циркуляции при одинаковой полосе пропускания фотоприемников за счет поляризационной модуляции сигнала на выходе контура циркуляции. Это приводит к такому же увеличению максимальной информационной емкости памяти при одинаковой длине контура. При этом происходит снижение основного противоречия между шириной полосы пропускания оптического канала и ограниченным быстродействием фотоприемников.

Литература

1. Bailey, D. Practical fiber optics / D. Bailey, E. Wright. – Newnes, 2003. – 288 p.

- 2. Пилипович, В. А. Циркуляционный волоконно-оптический контур памяти со встроенным служебным каналом / В. А. Пилипович, А. К. Есман, И. А. Гончаренко [и др.] // Квантовая электроника. 1995. Т. 22, № 10. С. 1019—1022.
- 3. Жуковский, А. В. Моделирование процесса рециркуляционного хранения информации в оптоволоконной динамической буферной памяти / А. В. Жуковский, А. В. Поляков // Вестник БГУ. Сер. 2. 2012. № 2. С. 31-36.
- 4. Поляков, А. В. Рециркуляционный метод измерения температуры волоконно-оптическим датчиком / А. В. Поляков // Проблемы физики, математики и техники. 2019. № 2 (39). С. 36–44.
- 5. Тимофеев, А. М. Устройство для передачи и приема двоичных данных по волоконно-оптическому каналу связи / А. М. Тимофеев // Приборы и методы измерений. 2018. Т. 9, № 1. С. 17–27.
- 6. Рябцев, В. Г. Средства восстановления работоспособности модулей памяти систем управления критического применения / В. Г. Рябцев, С. В. Волобуев // Технический сервис машин. 2019. № 2 (135). С. 33—39.
- 7. Нелинейные эффекты в волоконной оптике: учеб. пособие / В. Г. Беспрозванных, В. П. Первадчук. Пермь: Перм. нац. исслед. политехн. ун-т, 2011.-228 с.

УДК 538.54.16

Studies of the correlation between superconducting transition temperature and anion defectivity in thallium-based ceramics

Savchuk G. K., Yurkevich N. P. Belarusian National Technical University Minsk, Republic of Belarus

The paper presents the results of studies of the influence of the anion defectiveness on the transition temperature to the superconducting state of thallium-containing superconductors. It is shown that the anion defectiveness is associated with a change in the oxygen O3 content in the thallium plane and oxygen O1 in the copper plane. It was found that the transition temperature depends on the bond lengths Tl-O3, Cu-O2 and Cu-O1.

Anion defectivity in superconducting ceramics is one of the sources generating charge carriers (holes) in them.